

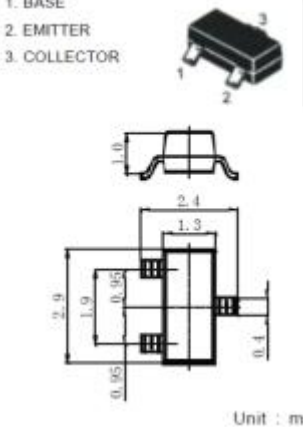
### 高频三极管

**简介：** 主要用于电子设备的一般用途放大器，中等功率驱动器及中速开关应用等

**特点：** ★ 优越的HFE 线性，电流大。 ★ SS8550 与 SS8050 互补。

**产品标准：**

最大规格 (Ta=25℃) SOT-23

| 参数       | 符号        | 规格   | 单位 | <b>SOT-23</b><br>1. BASE<br>2. EMITTER<br>3. COLLECTOR<br> |
|----------|-----------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 集电极-基极电压 | $V_{CBO}$ | 40   | V  |                                                                                                                                                |
| 集电极电流    | $I_C$     | 1200 | mA |                                                                                                                                                |
| 集电极功耗    | $P_C$     | 625  | mW |                                                                                                                                                |
| 结温       | $T_j$     | 150  | ℃  |                                                                                                                                                |

点特性 (Ta=25℃)

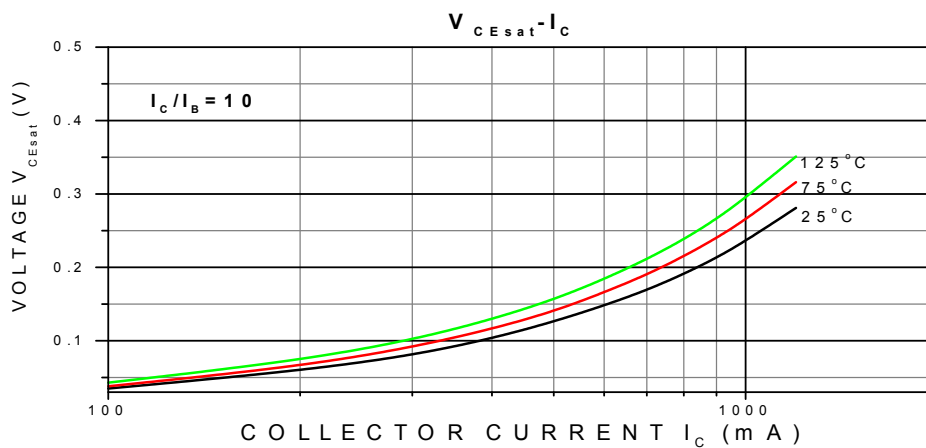
| 参数          | 符号            | 测试条件                               | 最小  | 典型 | 最大  | 单位      |
|-------------|---------------|------------------------------------|-----|----|-----|---------|
| 集电极-基极击穿电压  | $BV_{CBO}$    | $I_C=0.1mA, I_E=0$                 | 40  |    |     | V       |
| 集电极-发射极击穿电压 | $BV_{CEO}$    | $I_C=1mA, I_B=0$                   | 25  |    |     | V       |
| 发射极-基极击穿电压  | $BV_{EBO}$    | $I_E=0.1mA, I_C=0$                 | 5   |    |     | V       |
| 集电极-基极截止电流  | $I_{CBO}$     | $V_{CB}=35V, I_E=0$                |     |    | 0.1 | $\mu A$ |
| 集电极-发射极截止电流 | $I_{CEO}$     | $V_{CE}=20V, I_B=0$                |     |    | 3.0 | $\mu A$ |
| 发射极-基极截止电流  | $I_{EBO}$     | $V_{EB}=4V, I_C=0$                 |     |    | 0.1 | $\mu A$ |
| 直流电流增益      | $h_{FE}$      | $V_{CE}=1V, I_C=100mA$             | 85  |    | 400 |         |
|             |               | $V_{CE}=1V, I_C=1mA$               | 60  |    |     |         |
| 集电极-发射极饱和电压 | $V_{CE(sat)}$ | $I_C=800mA, I_B=80mA$              |     |    | 0.5 | V       |
| 基极-发射极饱和电压  | $V_{BE(sat)}$ | $I_C=800mA, I_B=80mA$              |     |    | 1.2 | V       |
| 特征频率        | $f_T$         | $V_{CE}=6V, I_C=20mA$<br>$f=30MHz$ | 150 |    |     | MHz     |

HFE 分档范围: (允许测试误差 10%)

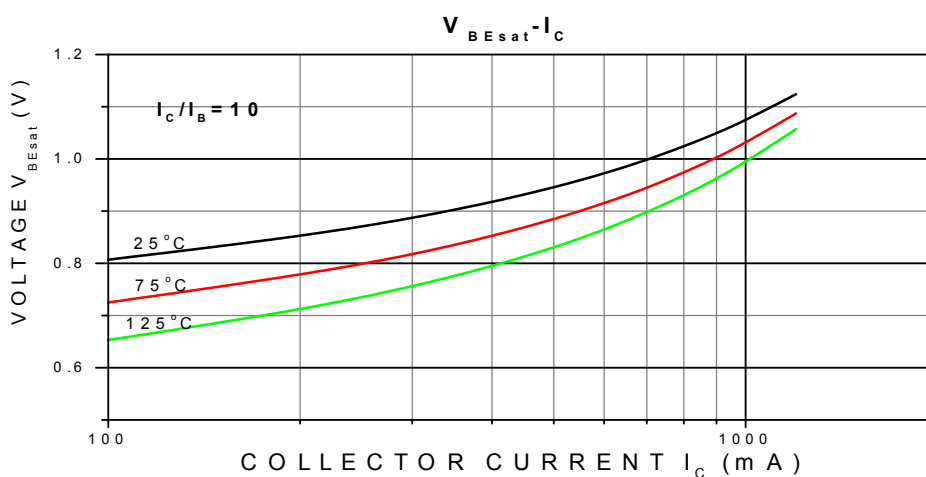
|         |
|---------|
| Y1      |
| 200-300 |

### 特性曲线

COLLECTOR-EMITTER SATURATION



BASE-EMITTER SATURATION



DC CURRENT GAIN  $h_{FE}$

